**Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Ким Чан Вом, 0**

**ВВЕДЕНИЕ.**

**ГЛАВА ПЕРВАЯ.ОБЗОР ЛИТЕРАТУШ.**

**§1.Источники неоднородности границы раздела.**

**1.1.1.Неоднородность по работе выхода металла.**

**IЛ.2.Неоднородность поверхности: полупроводника.**

**1.1.3.Реакция и. взаимодиффузия.**

**1.1.4.Периферийная неоднородность.**

**§2.Экспериментальные факты,доказывающие несостоятельность однородной модели.**

**1.2.I.Однородная модель контакта металла с полупроводником.**

**1.2.2.Дисперсия высоты барьера Срв**

**1.2.3.Трудность предсказания поведения контакта.**

**1.2.4.Корреляция между высотой барьера ДШ и работой выхода металла.**

**1.2.5.Зависимость высоты барьера ДШ фв от площади КМП.**

**1.2.6.Температурная зависимость ВАХ ДШ.**

**1.2.7.Разновидности ВАХ в прямом направлении.**

**1.2.8.Разновидности ВАХ в обратном направлении.**

**1.2.9.Зависимость напряжения пробоя от площади КМП.**

**ГЛАВА ВТОРАЯ.ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ iMHSOVM-nSi ДШ**

**И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА.**

**§1.Технология изготовления {M+{Si1}fM -hSl ДШ.**

**§2.Экспериментальная методика.**

**§3.Электрическая схема и установка зонда.**

**ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ВЛИЯНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ НА**

**СВОЙСТВА (М + <Si))/М - п Si ДИОДОВ ИЮТТКЙ.**

**§1.Влияние площади КМП на свойства**

**M+<SO)/M-riSL дш.**

**§2.Влияние толщины плёнки алюминия cLm на свойства (M+<Sl>)/M -nSi диодов Шоттки.**

**ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ.ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ**

**НА СВОЙСТВА ДИОДОВ ГОТТКИ.**

**§1.Влияние одноосного давления на свойства**

**- П- Si диодов Шоттки.**

**§2.Температурная зависимость ВАХ**

**Ж + <Si>)/j£ -Л Si диодов Шоттки.**

**§3.Влияние термоотжига на свойства**

**М +<SO)/M-n Si диодов Шоттки.**